



Э Т И К Е Т К А

Микросхемы типов

KP198HT5, KP198HT6, KP198HT7, KP198HT8

соответствуют ГОСТ 18725-73

и техническим условиям

ОК0.348.483 ТУ



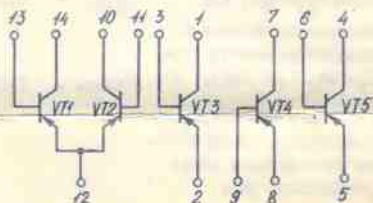
Матрица транзисторов p-n-p типа

Схема расположения выводов



Схема электрическая

принципиальная для KP198HT5



Для KP198HT6 без транзистора VT4

Для KP198HT7 без транзистора VT1

Для KP198HT8 без транзисторов VT2, VT5

Масса не более 2,0 г

Содержание драгоценных металлов в одной микросхеме:

ЗОЛОТО

мг

0.4554 мг - 3 \wedge 999.9

Основные электрические параметры при $T = 25 \pm 10^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	КР198НТ5А		КР198НТ5Б		КР198НТ7А		КР198НТ7Б	
		не ме-ние	не ме-ние	не ме-ние	не ме-ние	не ме-ние	не ме-ние	не ме-ние	не ме-ние

Статический коэффициент передачи тока транзистора в схеме с общим эмиттером (при $U_{КБ} = 3\text{В}$, $I_3 = 0,5\text{мА}$)	h_{213}	20	125	60	300	20	125	60	300
--	-----------	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

Напряжение насыщения база-эмиттер (при $I_K = 3\text{мА}$, $I_B = 0,5\text{мА}$), В	$U_{БЭнас}$	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0
---	-------------	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

Обратный ток коллектора (при $U_{КБ} = 6\text{В}$), мкА	$I_{КБО}$	-	0,3	-	0,3	-	0,3	-	0,3
--	-----------	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

Напряжение насыщения Коллектор-эмиттер (при $I_K = 3\text{мА}$, $I_B = 0,5\text{мА}$), В	$U_{КЭнас}$	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0
--	-------------	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

Разброс статических коэффициентов передачи тока транзисторов дифференциальной пары,

$\frac{h_{213max} - h_{213min}}{h_{213max}} \cdot 100$ (при $U_{КБ} = 3\text{В}$, $I_3 = 0,5\text{мА}$), %	Δh_{213}	-	15	-	15	-	-	-	-
---	------------------	---	----	---	----	---	---	---	---

Разброс напряжений между базой и эмиттером транзисторов дифференциальной пары (при $\Sigma I_3 = 0,5\text{мА}$, $U_{КБ} = 3\text{В}$), мВ	$5U_{БЭ}$	-	4	-	4	-	-	-	-
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Место для штампа ОТК

